

Objektyp: **FrontMatter**

Zeitschrift: **Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins :
gemeinsames Publikationsorgan des Schweizerischen
Elektrotechnischen Vereins (SEV) und des Verbandes
Schweizerischer Elektrizitätswerke (VSE)**

Band (Jahr): **62 (1971)**

Heft 24

PDF erstellt am: **14.08.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

BULLETIN

DES SCHWEIZERISCHEN ELEKTROTECHNISCHEN VEREINS

Gemeinsames Publikationsorgan des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins (SEV)
und des Verbandes Schweizerischer Elektrizitätswerke (VSE)

Inhaltsverzeichnis

Allocution présidentielle présentée à l'Assemblée générale de l'ASE du 25 septembre 1971 à Flims. Par R. Richard	1157
Protokoll der 87. (ordentlichen) Generalversammlung des SEV	1160
Hässliche Schweiz? Von U. Kägi	1165
Ansprachen anlässlich der gesellschaftlichen Veranstaltungen an der Jahresversammlung des SEV und VSE vom 24. September 1971 in Flims	1171
John Logie Baird	1173
Technische Mitteilungen	
Beleuchtung von Fussballplätzen für das Farbfernsehen	1174
Gerät zum Erkennen gesprochener Zahlen	1174
Integrierte Hybridschaltungen in Dünnschichttechnik für Mikrowellen	1174
Mitteilungen	
Persönliches und Firmen	1191
Kurzberichte	1191
Verschiedenes	1191
Vereinsnachrichten	
<i>Sitzungen</i>	
Sicherheitsausschuss, FK 15C, FK 20 des CES	1195
FK 40 des CES	1196
<i>Weitere Vereinsnachrichten</i>	
Inkraftsetzung der Publikation 3149-3.1971 des SEV, «Regeln des SEV, Ausrüstungen für elektroakustische Anlagen»	1196
Inkraftsetzung der Publikation 3167.1971 des SEV, «Regeln für direktwirkende Registriergeräte und deren Zubehör»	1196
Inkraftsetzung der Publikation 9001-9A.1971 des SEV, «Ergänzung zur 1. Auflage der Regeln und Leitsätze des SEV, Graphische Symbole für Telephonie, Telegraphie und Wandler»	1196

Energie-Erzeugung und -Verteilung, Seiten des VSE

Die Elektrizität und die moderne Industriegesellschaft oder das Ergebnis einer Marktforschung und die Wirklichkeit Präsidialansprache anlässlich der Mitgliederversammlung der Elektrowirtschaft am 8. Oktober 1971 in Luzern. Von G. Hertig	1175
37. Diskussionsversammlung des VSE am 2./3. Juni 1971 in Lausanne Bauweise eines städtischen Mittelspannungsnetzes. Von J. Schell	1177
Wirtschaftliche Mitteilungen	
Verbrauch elektrischer Energie in der Schweiz für Haushalt, Gewerbe und Landwirtschaft	1185
Der Landesindex der Konsumentenpreise Ende Oktober 1971	1186
Erzeugung und Abgabe elektrischer Energie durch die schweizerischen Elektrizitätswerke der Allgemeinversorgung	1188
Gesamte Erzeugung und Verwendung elektrischer Energie in der Schweiz	1189

Für drei Hauptanwendungen empfehlen wir unsere

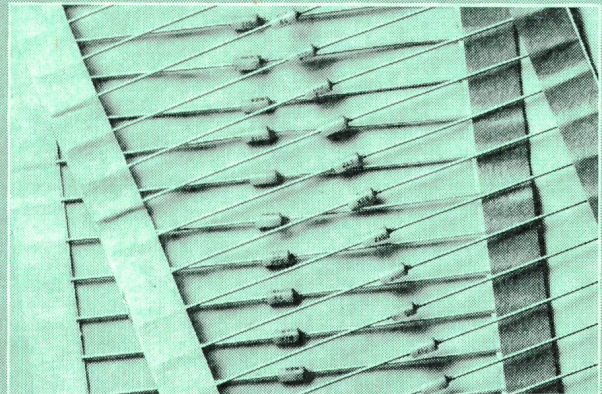
Vierschichtdiode BRY39

- als Silicon Controlled Switch (SCS)
- als Thyristor-Tetrode
- als programmierbarer Unijunction Transistor (PUT)

Und was Sie besonders interessiert: die technischen Daten und die Preise der BRY 39 lassen sich zeigen!

Verlangen Sie unsere Product Information 129: BRY 39 Applications

Haben Sie schon...



... die Si-Planar-Z-Diode BZX79C im DO-35-Gehäuse?

Für den 400-mW-Bereich wird modernste Halbleitertechnologie (Planar-Epitaxial-Kristall) mit dem Standard-Dioden-Gehäuse DO-35 kombiniert. Neben den günstigen Gehäuseabmessungen bietet die neue Typenreihe erhebliche Vorteile gegenüber DO-7-Glas- oder Plastikdioden:

Steile Durchbruchcharakteristik
Abrupter Übergang zwischen Sperr- und Durchbruchgebiet (scharfer Kennlinienknick)
Erheblich kleineres Rauschen
Extrem kleine Restströme gegenüber diffundierten und legierten Z-Dioden
Hohe mechanische Festigkeit aufgrund der Druckkontaktierung
Günstiger Preis
Die wichtigsten Daten der 30 Typen umfassenden Planar-Reihe BZX79C ...:

Spannungsbereich	4,7 ... 75 V
Toleranz	±5%
Verlustleistung ($T_{\text{umg.}} = 50^\circ\text{C}$)	400 mW
Sperrschichttemperatur	200 °C

Ganze Typenreihe auch mit 2% Toleranz lieferbar.

PHILIPS

Abteilung Halbleiter
und Baueinheiten
8027 Zürich, Postfach
Tel. 01 44 2211 int. 464



Bauelemente
für die
Elektronik

